

Revendicări:

Fotodiodă selectivă pe baza heterostructurii ce constă din substratul n^+InP cu banda energetică interzisă E_{g_0} , stratul activ $In_{x_1}Ga_{1-x_1}As_{y_1}P_{1-y_1}$ cu E_{g_1} , stratul frontal $p^+ In_{x_2}Ga_{1-x_2}As_{y_2}P_{1-y_2}$ cu E_{g_2} și stratul antireflectant pe partea frontală cu E_{g_3} , unde $E_{g_1} < E_{g_2} < E_{g_0} < E_{g_3}$, **caracterizată prin aceea că** joncțiunea p-n este formată în stratul frontal în imediata apropiere de heterogranita cu stratul activ intrinsec, iar grosimea stratului frontal este mai mare decât lungimea de difuziune a purtătorilor de sarcină minoritari generați pe suprafața frontală a fotodiodei.